

Power MOSFET

F11S80C3

800V 11A

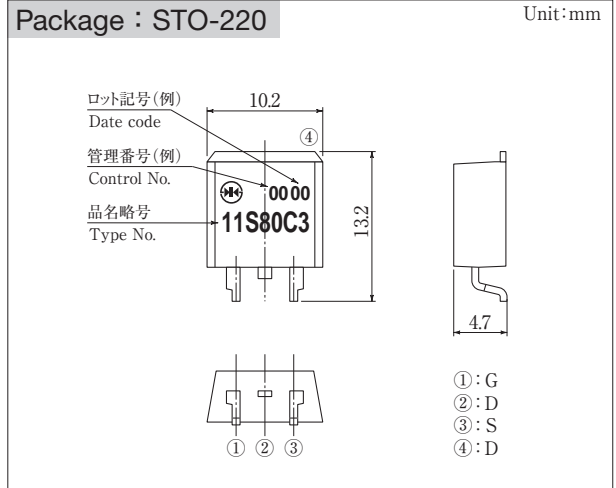
特長

- 低オン抵抗
- 高速スイッチング
- 面実装タイプ

Feature

- Low R_{ON}
- Fast Switching
- SMD Package

■ 外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■ 定格表 RATINGS

● 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T_c = 25°C)

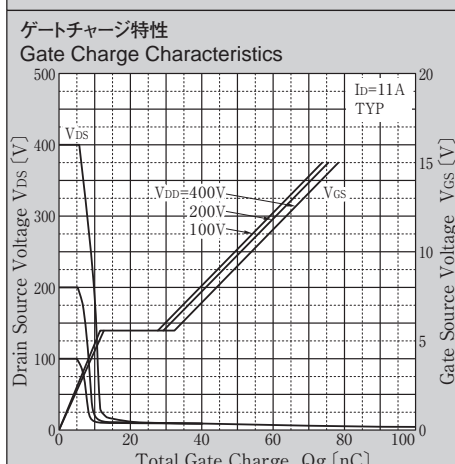
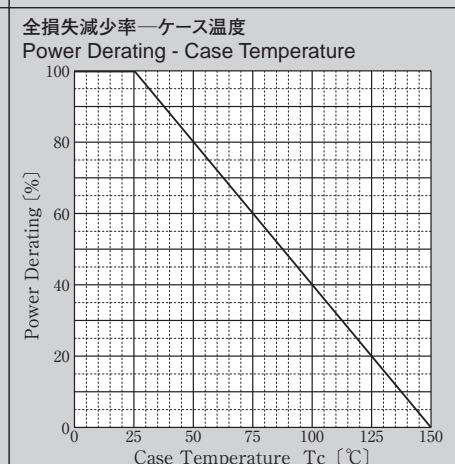
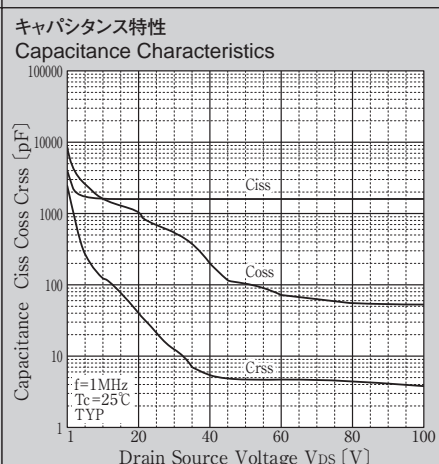
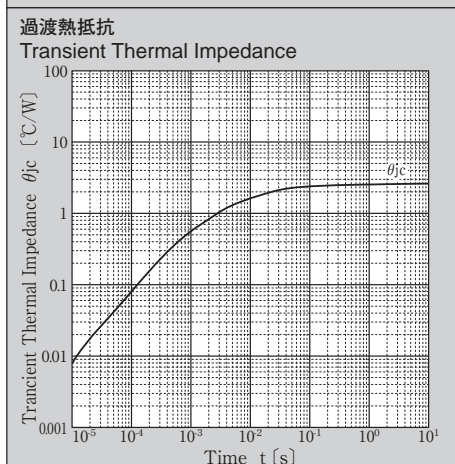
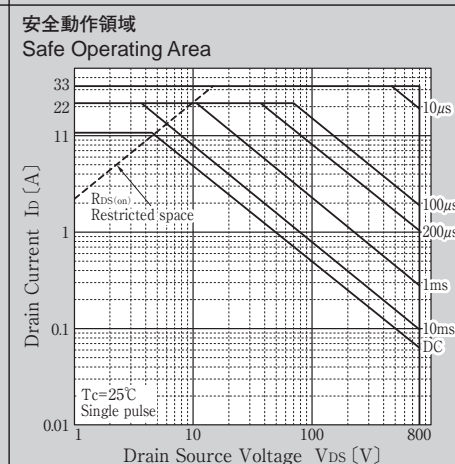
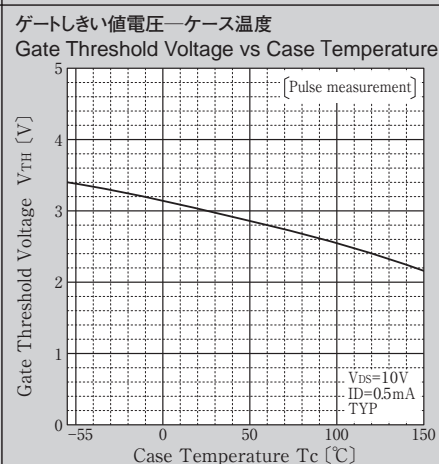
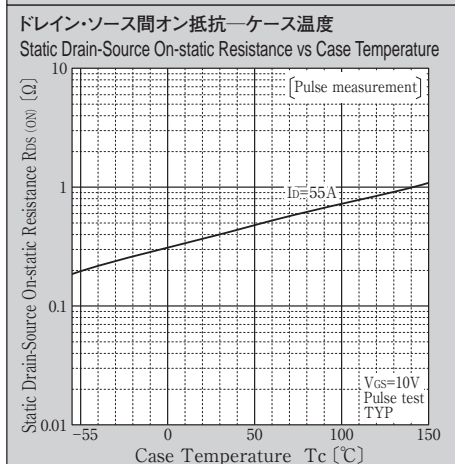
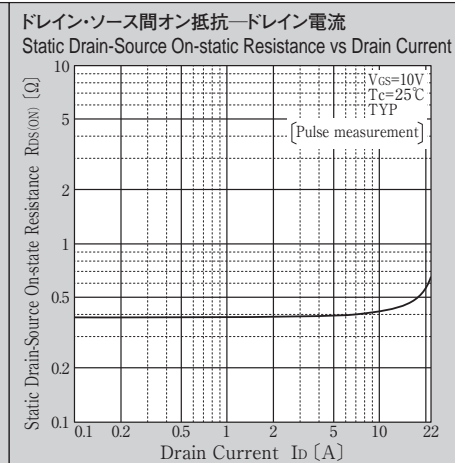
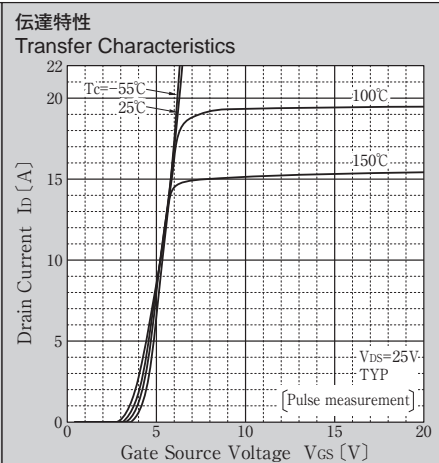
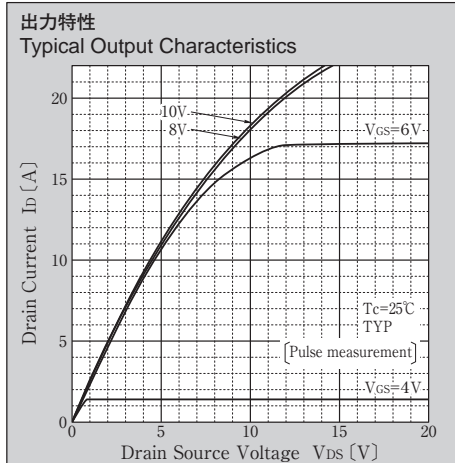
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}		-55~150	°C
チャネル温度 Channel Temperature	T _{ch}		150	
ドレイン・ソース間電圧 Drain-Source Voltage	V _{DSS}		800	V
ゲート・ソース間電圧 Drain-Source Voltage	V _{GSS}		±30	
ドレイン電流(直流) Continuous Drain Current (DC)	I _D		11	A
ドレイン電流(ピーク) Continuous Drain Current (Peak)	I _{DP}	パルス幅10μs, duty=1/100 Pulse width 10μs, duty=1/100	33	
ソース電流(直流) Continuous Source Current (DC)	I _S		11	
全損失 Total Power Dissipation	P _T		50	W

● 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T_c = 25°C)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			MIN	TYP	MAX	
ドレイン・ソース間降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V _{(BR)DSS}	I _D = 1mA, V _{GS} = 0V	800	—	—	V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} = 800V, V _{GS} = 0V	—	—	25	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} = ±30V, V _{DS} = 0V	—	—	±0.1	
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _{fs}	I _D = 5.5A, V _{DS} = 10V	4.2	8.3	—	S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R _{(DS)ON}	I _D = 5.5A, V _{GS} = 10V	—	0.39	0.45	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	I _D = 0.5mA, V _{DS} = 10V	2.1	3.0	3.9	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S = 5.5A, V _{GS} = 0V	—	—	1.5	
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	—	—	2.5	°C/W
ゲート全電荷量 Total Gate Charge	Q _g	V _{GS} = 10V, I _D = 11A, V _{DD} = 400V	—	54	—	nC
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} = 25V, V _{GS} = 0V, f = 1MHz	—	1690	—	pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}		—	22	—	
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}		—	740	—	
ターンオン遅延時間 Turn-on delay time	t _{d(on)}	I _D = 5.5A, V _{DD} = 150V, R _L = 27.3Ω V _{GS(+)} = 10V, V _{GS(-)} = 0V	—	21	—	ns
上昇時間 Rise time	t _r		—	30	—	
ターンオフ遅延時間 Turn-off delay time	t _{d(off)}		—	225	—	
下降時間 Fall time	t _f		—	35	—	

*ケース温度によりジャンクション温度を算出する場合の熱抵抗値は、1.2 [°C/W] を御使用下さい。但し、上記印加電流、電圧は安全動作領域内での御使用を前提とします。
The Junction Temperature is calculated from the case temperature, thermal resistance value uses 1.2°C/W. Use in the Safe Operating Area for input current and voltage.

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.